

## ГИГАНТСКАЯ ОДНОНАПРАВЛЕННАЯ АНИЗОТРОПИЯ СКОРОСТИ ДОМЕННЫХ ГРАНИЦ В ТОНКИХ МАГНИТНЫХ ПЛЕНКАХ

Ф.В. Лисовский, А.С. Логгинов, Г.А. Непокойчицкий,  
Т.Б. Розанова

Впервые обнаружены динамические преобразования структуры доменных границ (ДГ), происходящие в дискретных временных интервалах в узком диапазоне импульсных магнитных полей. В тонких магнитных пленках с плоскостной анизотропией они приводят к сильной односторонней анизотропии скорости ДГ ( $V_{max}/V_{min} > 4$ ).

Известно<sup>1,2</sup>, что предельная скорость движения доменных границ (ДГ) в монокристаллических пленках ферритов-гранатов (ФГ) существенно увеличивается, если образец обладает ромбической компонентой анизотропии, которая наиболее сильно проявляется в пленках, выращенных на подложках ориентации (110). Этот эффект, инвариантный относительно изменения направления движения, неоднократно наблюдался косвенными методами в экспериментах по исследованию стационарного движения ДГ<sup>3-5</sup>. Переход к изучению нестационарных процессов прямыми экспериментальными методами позволил выявить ряд новых физических явлений, не укладывающихся в рамки существующих теоретических представлений.

Динамика ДГ изучалась методом электронно-оптической высокоскоростной фотографии с временным и пространственным разрешениями соответственно  $\sim 8$  нс и  $\sim 0,3$  мкм<sup>6</sup>. Образцами служили эпитаксиальные пленки ФГ с ориентацией (110); далее приводятся результаты для образца состава  $(Y\text{GdTbBi})_3(\text{FeAl})_5\text{O}_{12}$  со следующими параметрами: толщина  $h \approx 10,9$  мкм, намагниченность насыщения  $4\pi M_s \approx 175$  Гс, поле коллапса цилиндрических магнитных доменов (ШМД)  $H_0 \approx 130$  Э, константы анизотропии: одноосной  $K_u \approx 4210$  эрг/см<sup>3</sup>, ромбической  $K_p \approx 15560$  эрг/см<sup>3</sup>, кубической  $K_1 \approx 4580$  эрг/см<sup>3</sup>.

Исследовалось радиальное расширение ЦМД в практически однородном импульсном магнитном поле  $H_{имп}$ , создаваемом плоскими однослойными катушками. Время нарастания импульса поля  $H_{имп}$  не превышало 2 нс, а напряженность  $H_{имп}$  изменялась от 0 до 150 Э. В исходном состоянии образец находился в постоянном поле смещения  $H_{см} < H_0$ , и в нем существовали изолированные ЦМД (рис. 1, A, a). Затем прикладывалось поле  $H_{имп}$ , антипараллельное  $H_{см}$ , и в различные моменты времени  $\tau$ , отсчитываемые от начала импульса, исследовалась динамика ДГ ЦМД (рис. 1). Для детального изучения особенностей поведения отдельных участков ДГ эксперименты проводились с двухимпульсной подсветкой, позволяющей регистрировать на одной фотографии исходное положение ЦМД и его форму в произвольный момент времени  $\tau$  (рис. 1, B). Существенными отличиями условий данного эксперимента от выполненных ранее<sup>3-5</sup> являются: 1) использование импульсов магнитного поля с предельно коротким фронтом ( $\sim 2$  нс); 2) прямое исследование динамики ДГ с близким к предельному пространственным разрешением; 3) возможность одновременно исследовать динамику ДГ, ориентированных произвольным образом относительно кристаллографических осей; 4) возможность точного определения смещений отдельных участков ДГ за произвольный интервал времени  $\tau$  во время действия одиночного импульса поля.

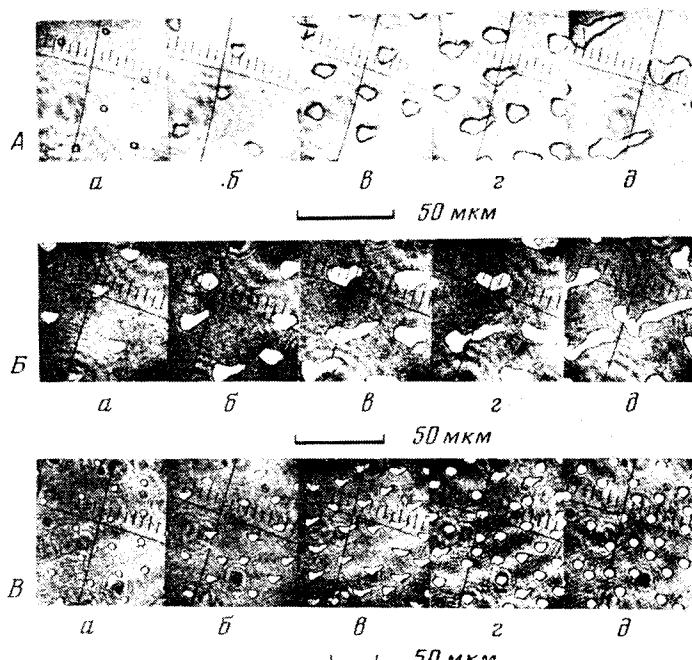


Рис. 1. A. Форма доменов через различные интервалы времени после начала импульса магнитного поля. Поляроиды полностью скрещены.  $H_{см} = 128$  Э.  $H_{имп} = 66$  Э.  $\tau$ : a – 0 нс; б – 10 нс; в – 15 нс; г – 25 нс; д – 60 нс. Б. Искажения формы ЦМД в различные моменты времени после приложения импульса поля  $H_{имп}$ . Использовалась двухимпульсная подсветка.  $H_{см} = 129$  Э.  $H_{имп} = 68$  Э.  $\tau_1 = 0$ .  $\tau_2$ : а – 10 нс; б – 30 нс; в – 50 нс; г – 70 нс; д – 100 нс. В. Динамические доменные конфигурации, возникающие в различных полях  $H_{имп}$  через  $\tau \approx 30$  нс после приложения импульса поля.  $H_{см} = 121$  Э.  $H_{имп}$ : а – 27 Э; б – 53 Э; в – 64 Э; г – 80 Э; д – 97 Э

Установлено, что после приложения импульса поля  $H_{имп}$  ДГ с любой ориентацией начинают двигаться практически мгновенно и уже в первые наносекунды движения ( $\tau < 10$  нс) достигают столь высоких скоростей ( $V > 500$  м/с), что за время экспозиции ( $\sim 8$  нс) четкого изображения ДГ зафиксировать не удается (см. "размытые" участки ДГ на рис. 1, A, B – д). Однако, уже при  $\tau \approx 10$  нс скорость движения ДГ снижается настолько ( $V \approx 150$  м/с), что

практически все доменные стенки ЦМД фиксируются на фотографиях (рис. 1, A, б). Изучение особенностей данного явления показало, что высокая скорость движения ДГ ( $V > 500$  м/с) при  $\tau \gtrsim 10$  нс, как правило, может сохраняться лишь у единственного участка границы ЦМД (рис. 1), определенным образом ориентированного относительно кристаллографических осей (см. вставку на рис. 2), в то время, как скорость ДГ любой другой ориентации стабилизируется на уровне  $\sim 150$  м/с. На фотографиях с временем экспозиции  $\sim 8$  нс гигантская однонаправленная анизотропия скорости ДГ ( $V_{max}/V_{min} > 4$ ) проявляется как "разрыв" доменной стенки ЦМД (рис. 1, A, в, г, д). С течением времени ( $\tau > 10$  нс) она приводит к сильным искажениям формы доменов (рис. 1, A, д; Б, в, г, д). Аномально высокая скорость одного участка ДГ ЦМД сохраняется лишь в течение  $\sim 20$  нс после приложения импульса поля, а затем ( $\tau > 20$  нс) у большинства доменов она снижается до скорости, характерной для других участков ДГ. Лишь у единичных ЦМД однонаправленная анизотропия скорости ("разрыв" ДГ) сохраняется в течение  $\tau \gtrsim 50$  нс (рис. 1, A, д; Б, д).

Исследование зависимостей расстояний, пройденных различными участками ДГ ЦМД, от времени, и анализ разброса расстояний, пройденных аномальными участками границы, за различные интервалы времени  $\tau$ , дают основание предположить, что существуют дискретные отрезки времени, кратные  $\Delta t \approx 10$  нс, в течение которых может проявляться однонаправленная анизотропия скорости. Таким образом, снижение аномально большой скорости происходит в моменты времени  $\tau \approx 10, 20, 30$  нс и т.д.

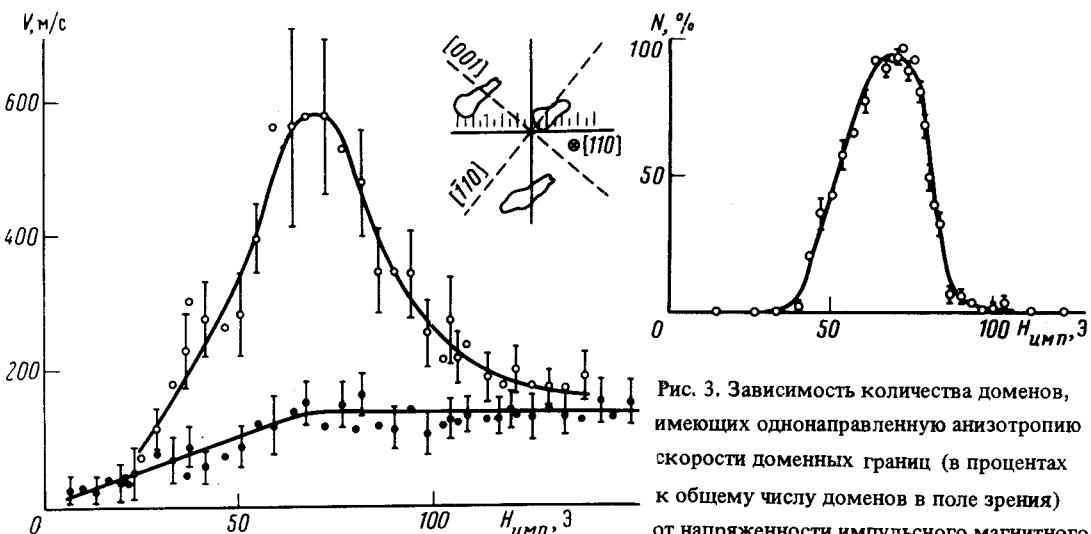


Рис. 2. Зависимость максимальной скорости ДГ в выделенном направлении (○) и минимальной скорости (●) от напряженности импульсного магнитного поля. На вставке представлено схематическое изображение доменов с рис. 1, A, д и ориентация важнейших кристаллографических осей в плоскости образца

Поскольку ДГ любой ориентации движутся неравномерно во времени, то значение средней скорости  $\bar{V}$  зависит от времени усреднения  $\Delta t$ . Поэтому для оценки средних скоростей ДГ на начальном этапе движения измерения и расчеты проводились при  $\Delta t \approx 10$  нс. На рис. 2 представлены зависимости от  $H_{имп}$  минимальной и максимальной (вдоль направления максимальных искажений формы доменов) скоростей  $V$  участков ДГ ЦМД.

Характерная особенность обнаруженных явлений состоит в том, что они проявляются в относительно узком диапазоне изменения импульсных полей (рис. 1, В, рис. 2). Из рис. 1, В хорошо видно, что количество ЦМД, у которых наблюдается однонаправленная анизотропия скорости ДГ, сильно зависит от напряженности  $H_{имп}$ . На рис. 3 представлена зависимость числа таких ЦМД, нормированная на общее количество доменов, от  $H_{имп}$ . Видно, (рис. 1, В,

рис. 3.), что в полях  $H_{\text{имп}} \approx 60 - 75$  Э практически у всех ЦМД проявляются искажения формы, связанные с односторонней анизотропией скорости ДГ.

Установлено, что обнаруженные явления не связаны с неоднородностью импульсного поля и его нестационарностью во времени. Таким образом, в данных экспериментах впервые наблюдались динамические процессы преобразования структуры ДГ во время их движения в однородном магнитном поле.

#### Литература

1. Schlomann E. J. Appl. Phys., 1976, **47**, 1142.
2. Breed D.J., de Geus W., Enz U. J. Appl. Phys., 1980, **51**, 2780.
3. Breed D.J., van der Heijden A.M.J., Logmans H., Voermans A.B. J. Appl. Phys., 1978, **49**, 939.
4. Breed D.J., Nederpel P.Q.J., de Geus W. J. Appl. Phys., 1983, **54**, 6577.
5. Breed D.J., de Geus W., Voermans A.B., van Bakel B.A.H. J. Appl. Phys., 1982, **53**, 2546.
6. Иванов Л.П., Логгинов А.С., Непокойчицкий Г.А. ЖЭТФ, 1983, **84**, 1006.